

2SK2633LS

NチャンネルMOS形シリコン電界効果トランジスタ
超高速スイッチング用

暫定規格

- 特長
- ・低オン抵抗。
 - ・低Q_g化。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25°C

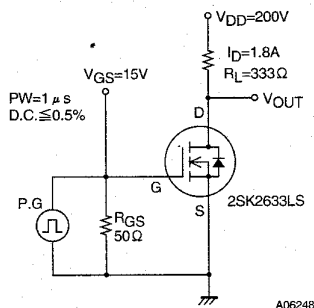
			unit
ドレイン・ソース電圧	V _{DSS}	800	V
ゲート・ソース電圧	V _{GSS}	±30	V
ドレイン電流 (DC)	I _D	3	A
ドレイン電流 (パルス)	I _{DP}	9	A
許容損失	P _D	30	W
チャネル温度	T _{ch}	150	°C
保存周囲温度	T _{stg}	-55~+150	°C

Tc=25°C

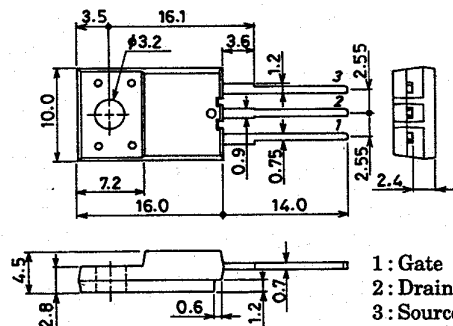
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25°C

			min	typ	max	unit
ゲート・ソース降伏電圧	V _{(BR)DSS}	I _D =1mA, V _{GS} =0	800			V
ドレイン・ソースシャ断電流	I _{DSS}	V _{DS} =800V, V _{GS} =0			1.0	mA
ゲート・ソースもれ電流	I _{GSS}	V _{GS} =±30V, V _{DS} =0			±100	nA
カットオフ電圧	V _{GS(off)}	V _{DS} =10V, I _D =1mA	3.5		5.5	V
順伝達アドミタンス	Y _{fs}	V _{DS} =10V, I _D =1.8A	0.9	1.8		S
飽和抵抗	R _{DS(on)}	I _D =1.8A, V _{GS} =15V		2.8	3.6	Ω
入力容量	C _{iss}	V _{DS} =20V, f=1MHz		700		pF
出力容量	C _{oss}	V _{DS} =20V, f=1MHz		180		pF
帰還容量	C _{rss}	V _{DS} =20V, f=1MHz		100		pF
ゲート入力電荷量	Q _g	V _{DS} =200V, I _D =3A V _{GS} =10V		20		nC
ターンオン遅延時間	t _{d(on)}	下図指定回路において		20		ns
立上り時間	t _r	"		20		ns
ターンオフ遅延時間	t _{d(off)}	"		50		ns
下降時間	t _f	"		25		ns
ダイオード順電圧	V _{SD}	I _S =3A, V _{GS} =0			1.2	V

スイッチングタイム測定回路図



外形図 2078B
(unit: mm)



SANYO: TO-220FI(LS)

本製品は開発中です。
詳細については営業担当者にご連絡ください。